Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0212U000436

Державний реєстраційний номер: 0109U000246

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-02-2012

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Закономірності вирощування напівпровідникових та над- провідних кристалів алмазу із заданими властивостями для цілеспрямованого використання при створенні електронних датчиків, зондів та приборів

Початок етапу: 01.2009

Закінчення етапу: 12.2011

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417377

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 044-468-86-32

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 3194.65

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Закономірності вирощування напівпровідникових та надпровідних кристалів алмазу із заданими властивостями для цілеспрямованого використання при створенні електронних датчиків, зондів та приборів

Назва роботи англійською:

Semi-conducting and superconducting diamond crystals growing laws with the set properties for purposeful use at creation of electronic gages, probes and devices

Реферат українською:

1.Проведено вивчення закономірностей утворення напівпровідникових алмазних монокристалів та надпровідних алмазних матеріалів при високих тисках та температурах з використанням розчинників вуглецю, бору та їх сполук; вивчення фізико-хімічних властивостей розплавів та їх контактних явищ з вуглецем

Реферат англійською:

3. Carry out of the studying laws of formation semi-conductor diamond monocrystals and superconducting diamond materials is spent at higher pressure and temperatures with use of solvents of carbon, boron and their connections; physical and chemical melt properties and their contact interactions with carbon are studied.

Індекс УДК: 539.2;538.9-405;548, 539.26:548.4:666.233

Коди тематичних рубрик: 29.19

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Івахненко Сергій Олексійович

Науковий ступінь: д. т. н.

Вчене звання: професор, член-кор.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Дослідно-лабораторна технологія отримання напівпровідникових монокристалів алмазу та надпровідних алмазних матеріалів при високих тисках та температурах

Назва НТП англійською: Experimentally-laboratory technology diamond semi-conductor monocrystals and superconducting diamond materials reception at high pressures and temperatures

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування:

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Розроблена дослідно-лабораторна технологія отримання напівпровідникових монокристалів алмазу та надпровідних алмазних матеріалів під впливом високих тисків (p=6-8ГПа) та температур (Т=1450-2250С) з метою використання у якості зондів для скануючої тунельної мікроскопії.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: залежить від терміну отримання дозвілу на використання в Україні

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: виробництва приладобудівної галузі

Перспективні ринки: Україна, країни ближнього та дальнього зарубіжжя

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обгрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

20 статей

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Новіков Микола Васильович

Перелік осіб-виконавців

Ільницька Г.Д.

Александрова Л.І.

Багно Н.Г.

Белявіна Н.М.

Білоусов І.С.

Виноградов С.О.

Гонтар О.Г.

Заневський О.О.

Катруша А.М.

Куцай О.О.

Лисаківський В.В.

Лисенко О.Г.

Логінова О.Б.

Марков А.І.

Олейник Г.О.

Перевертайло В.М.

Романко Л.І.

Соколов О.М.

Ткач В.М.

Шульженко О.О.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

